



STMicroelectronics et Innoscience signent un accord de développement et de fabrication pour la technologie GaN

- *Accord de développement conjoint (Joint Development Agreement - JDA) sur la technologie GaN (nitrure de gallium) pour construire l'avenir de l'électronique de puissance pour les data centers d'intelligence artificielle, la production et le stockage d'énergies renouvelables, les voitures et plus encore.*
- *Innoscence peut utiliser la capacité de production de STMicroelectronics en Europe tandis que ST peut tirer parti de la capacité de production d'Innoscence en Chine.*

Genève (Suisse) et Suzhou (Chine), le 31 mars 2025 - **STMicroelectronics (NYSE : STM)**, un leader mondial des semi-conducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, et **Innoscence (HKEX:02577.HK)**, le leader mondial de la fabrication à faible coût et haute performance de plaquettes de 8 pouces en nitrure de gallium sur silicium (GaN-on-Si), annoncent la signature d'un accord sur le développement et la fabrication de la technologie GaN (nitrure de gallium), en tirant parti des points forts de chaque entreprise pour renforcer les solutions de puissance en GaN et la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Les entreprises ont convenu d'une initiative de développement conjoint concernant la technologie de puissance GaN, afin de développer son futur prometteur dans les secteurs de l'électronique grand public, des data centers, des systèmes de puissance pour l'automobile et l'industriel et bien d'autres applications au cours des années à venir. De plus, l'accord permet à Innoscience d'utiliser la capacité de fabrication *front-end* de ST en dehors de la Chine pour ses plaquettes GaN, tandis que ST peut tirer parti de la capacité de fabrication *front-end* d'Innoscence en Chine pour ses propres plaquettes GaN. L'ambition commune est que chaque entreprise puisse élargir individuellement son offre en nitrure de gallium avec une flexibilité et une résilience de la chaîne d'approvisionnement pour répondre à tous les besoins de leurs clients dans un large éventail d'applications.

Marco Cassis, Président, Produits analogiques, Produits discrets et de puissance, MEMS et Capteurs de STMicroelectronics a déclaré : « *ST et Innoscience sont tous deux des fabricants intégrés de composants, et avec cet accord, nous tirerons parti de ce modèle au bénéfice de nos clients à l'échelle mondiale. Tout d'abord, ST accélérera sa feuille de route en technologie de puissance GaN pour compléter son offre en silicium et en carbure de silicium. Ensuite, ST pourra tirer parti d'un modèle de fabrication flexible pour servir les clients dans le monde entier* ».

Dr. Weiwei Luo, Chairman et cofondateur d'Innoscence, a déclaré : « *La technologie GaN est essentielle pour améliorer l'électronique, créant des systèmes plus compacts et plus efficaces qui économisent de l'énergie électrique, réduisent les coûts et diminuent les émissions de CO₂. Innoscience a été pionnier dans la fabrication de masse de la technologie GaN sur des plaquettes de 8 pouces et a livré plus d'un milliard de composants GaN dans plusieurs marchés, et nous sommes très heureux de s'engager dans une collaboration stratégique avec ST. La collaboration conjointe entre ST et Innoscience va encore étendre et accélérer l'adoption de la technologie* ».

GaN. Ensemble, les équipes d'Innoscence et de ST développeront les prochaines générations de la technologie GaN. »

Les composants de puissance GaN tirent parti des propriétés fondamentales des matériaux qui permettent de nouveaux standards de performance des systèmes dans la conversion de puissance, le contrôle de mouvement et l'actionnement, avec des pertes considérablement réduites, ce qui permet une efficacité accrue, des tailles réduites et un poids plus léger, réduisant ainsi le coût global de la solution et l'empreinte carbone. Ces composants sont en cours d'adoption rapide dans l'électronique grand public, les alimentations électriques industrielles et les data centers ainsi que les onduleurs solaires, et sont activement utilisés dans les groupes motopropulseurs des véhicules électriques de nouvelle génération en raison de leurs avantages substantiels en termes de réduction de taille et de poids.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d'approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l'énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d'objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d'affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % d'approvisionnement en électricité renouvelable d'ici la fin 2027.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

À propos d'Innoscence

Innoscence (HKEX:02577.HK) est le leader mondial de l'innovation dans la technologie du nitrure de gallium (GaN) et la fabrication de composants de puissance. La conception et les performances des composants d'Innoscence établissent la norme mondiale pour le GaN, et la culture d'amélioration continue accélérera les performances du GaN et son adoption par le marché. Les produits en nitrure de gallium de la société sont utilisés dans de multiples applications à basse, moyenne et haute tension, avec des nœuds technologiques en GaN allant de 15V à 1 200 V. Les plaquettes, les composants discrets, les circuits intégrés de puissance et les modules fournissent aux clients des solutions GaN robustes. Avec 800 brevets accordés ou en attente, les produits d'Innoscence sont réputés pour leur fiabilité, leurs performances et leur fonctionnalité dans les domaines de l'électronique grand public, de l'électronique automobile, des data centers, des énergies renouvelables et de la puissance pour l'industriel. Innoscence crée un avenir brillant pour le GaN. Pour plus d'informations, visitez le site www.Innoscence.com.

Pour plus d'informations, contacter :

RELATIONS PRESSE :

Nelly Dimey
Mobile : 06 75 00 73 39
nelly.dimey@st.com

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :

Jérôme Ramel
Vice-Président exécutif, Développement Corporate & Communication externe intégrée
Tél : +41 22 929 59 20
jerome.ramel@st.com